

产品概览

NCV57000: 隔离高电流和高能效 IGBT 门极驱动器，带内部电流隔离。

欲看完整文档，请参阅数据表。

NCV57000 是一款带内部电流隔离的高电流单沟道 IGBT 驱动器，适用于高功率应用中的高系统能效和可靠性。其功能包括互补输入、开路漏极 FAULT 和 Ready 输出、有源米勒箝位、准确 UVLO、DESAT 保护、DESAT 时的软关断，以及用于系统设计简便性的单独高低驱动器输出 (OUTH 和 OUTL)。NCV57000 可适应输入侧上 5V 和 3.3V 信号，以及驱动器侧上的宽偏置电压范围，包括负电压功能。NCV57000 提供 > 5 kVrms (UL1577 等级) 电流隔离和 > 1200 V_{ORM} (工作电压) 功能。NCV57000 采用宽体 SOIC-16 封装，可在输入和输出之间保证 8 mm 漏电距离，满足加强安全绝缘要求。

特性

- High Current Output(+4/-6 A) at IGBT Miller Plateau Voltages
- Short Propagation Delays with Accurate Matching
- DESAT with Soft Turn Off
- Active Miller Clamp and Negative Gate Voltage
- High Transient & Electromagnetic Immunity
- 5 kV Galvanic Isolation

优势

- Improves system efficiency
- Improves PWM signal integrity
- Protection against overload and short circuits
- Prevents spurious gate turn-on
- Ruggedness in fast slew rate high voltage and high current switching applications
- Galvanic isolation to separate high voltage and low voltage sides to provide safety and protection

应用

- Automotive Power Supplies
- HEV/EV Traction Inverters
- OBC
- BSG Inverters
- PTC Heaters

终端产品

- Automobiles
- xEV/EV Automobiles

器件电气规格

产品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Power Switch	Number of Outputs	Topology	Isolation Type	V _{in} Max (V)	V _{CC} Max (V)	Drive Source / Sink Typ (mA)	Rise Time (ns)	Fall Time (ns)	t _o Max (ns)	Package Type
NCV57000DWR2G		AEC Qualified PPAP Capable Pb-free Halide free	Active	IGBT SiC MOS FET	1	Single	Galvanic Isolation	5.5	24	6000 / 6000	10	15	90	SOIC-16W

欲了解更多信息，请联系您当地的销售支援 www.onsemi.cn。

创建于：9/30/2020